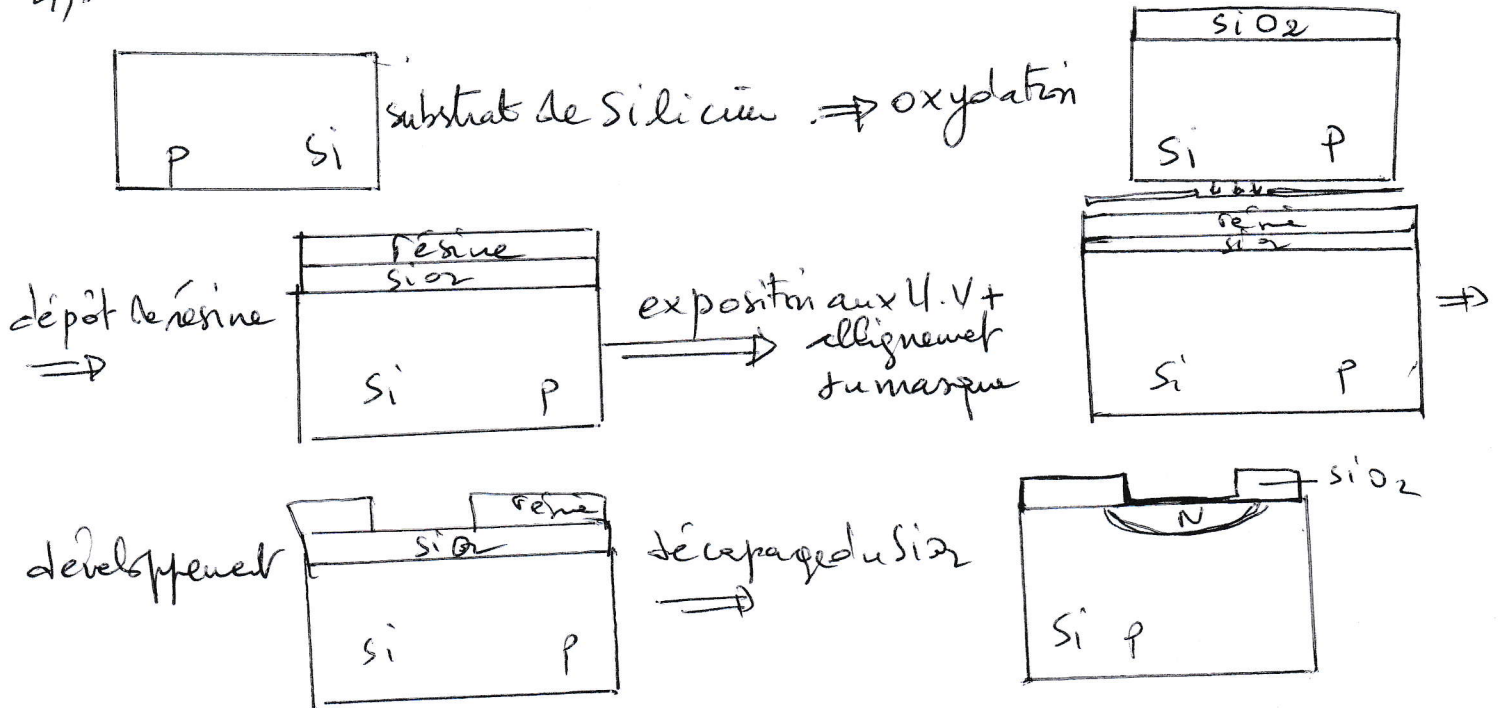


3) La jonction est la projection sur l'axe x (horizontal) de l'intersection des ombes avec 10^{17} cm^{-3} . (01)

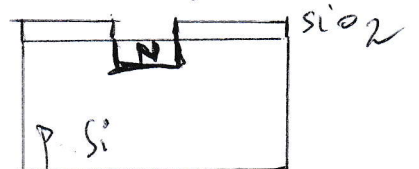
4).



(02) • Formation d'une jonction PN par photolithographie. (diffusion)

5). L'implantation ionique: on accélère sous vide un faisceau d'ions dopants, par une énergie comprise entre 30 et 200 keV. L'énergie d'accélération et le courant de faisceau déterminent la profondeur de pénétration des ions dans le Si. (01)

- Avantages: On utilise ce procédé lorsqu'il faut de minces couches dopées, donc pour le contrôle de concentrations de dopages dans les couches les plus étroites. Le procédé s'effectue à basse Température.
- schéma du profil du dopage



(01)